

Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có chế độ cộng hưởng bán hiệu suất cao, điện áp không đổi và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Các tính năng chính

MOSFET công suất tích hợp Điều khiển

phía sơ cấp cộng hư ởng bán hiệu suất cao

Điện áp không đổi và dòng điện đầu ra không đổi có độ chính xác cao

Công suất tiêu thụ khi chờ <75mW@265Vac Điều khiển phía

chính đa chế đô

Không có âm thanh bất thư ờng

trong quá trình hoạt động Phản ứng

động tuyệt vời Hiệu suất EMI đư ợc tối

ư u hóa Bù tổn thất đường dây tích hợp

Bảo vệ lỗi điểm đơn tích hợp

Chức năng bảo vệ tích hợp và toàn diện:

Bảo vệ ngắn mạch (FB SLP) Bảo vệ quá

nhiệt (OTP) Bảo vệ quá áp FB (FB

OVP) Bảo vệ quá áp VDD và bảo vệ dư ới áp và bảo

vệ kẹp Gói SOP-7/8, DIP-8, ASOP-6

Ứng dụng tiêu biểu

Bộ sạc điện thoại di động

Bộ đổi nguồn AC

Mô tả sản phẩm

KP2182X là công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp cộng hư ởng bán hiệu suất cao, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng bộ sạc. Trong điều kiện đầu ra tái đầy đú,

KP2182X hoạt động theo cơ chế cộng hư ởng gần đúng trên toàn bộ dái điện áp đầu vào. chế độ, do đó đạt đư ợc hiệu suất và khá năng tăng nhiệt độ tuyệt với.

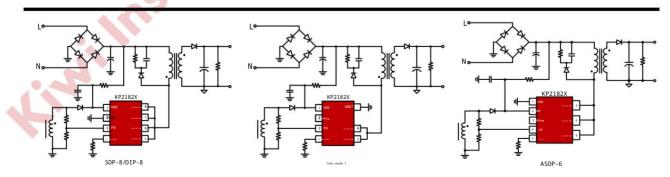
Sử dụng KP2182X có thể hoạt động mà không có âm thanh bất thư ởng và dấm bảo tuyệt vời hiệu suất năng động. Bằng cách sử dụng chức năng bù tổn thất đường đây tích hợp và chức năng bù dòng điện không đổi của điện áp đường đây, có thể đạt được hiệu suất đầu ra điện áp không đổi và dòng điện không đổi cao.

KP2182X tích hợp nhiều chức năng bảo vệ: Bảo vệ điện áp thấp VDD (UVLO), bảo vệ điện áp quá mức
VDD (VDD OVP), bảo vệ giới hạn đông điện theo chu kỳ (OCP), bảo vệ ngắn mạch (FB SLP), bảo vệ quá áp (FB OVP), bảo vệ quá nhiệt và kẹp VDD.

KP2182X còn tích hợp chức năng bảo vệ hệ thống điện khi xảy ra sự cố mất điện một điểm. Điện trở kéo lên hở, điện trở kéo xuống FB hở, điện trở kéo xuống FB ngắn, diode đầu ra hoặc SR ngắn, cuộn đây biến áp ngắn,

Nó có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy trong các điều kiện lỗi như RCS hở mạch và chân IC GND hở mạch.

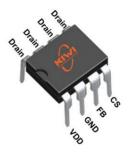
Mạch ứng dụng điển hình



Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Gói pin





DIP-8



Tiêu chuẩn 7



ASOP-6

Đánh dấu sản phẩm

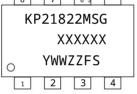
XXXXXX: Lô wafer Y: Mã năm

Tiêu chuẩn 8

WW: Mã tuần, 01-52

ZZ: số sê-ri, 01-99 hoặc A0-ZZ

F, S: mã kiểm soát nội bộ, 1-9 hoặc AZ, az 8 | 7 6 5

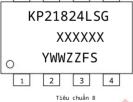


Tiêu chuẩn 8

XXXXXX: Lô wafer Y: Mã năm WW: Mã tuần, 01-52

ZZ: số sê-ri, 01-99 hoặc A0-ZZ

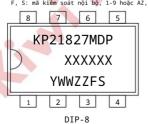
F, S: mã kiểm soát nội bộ, 1-9 hoặc AZ, az



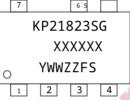
XXXXXX: lô wafer Y: Mã năm

WW: Mã tuần, 01-52 ZZ: số sê-ri, 01-99 hoặc A0-ZZ

F, S: mã kiểm soát nội bộ, 1-9 hoặc AZ, az



XXXXXX: Lô wafer Y: Mã năm WW: Mã tuần, 01-52 ZZ: số sê-ri, 01-99 hoặc A0-ZZ F, S: mã kiểm soát nội bộ, 1-9 hoặc AZ, az 6 5

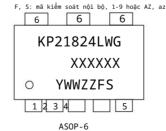


XXXXXX: Lô wafer Y: Mã năm WW: Mã tuần, 01-52 ZZ: số sê-ri, 01-99 hoặc A0-ZZ



XXXXXX: lô wafer Y: Mã năm WW: Mã tuần, 01-52

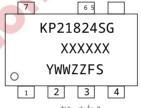
ZZ: số sê-ri, 01-99 hoặc A0-ZZ



XXXXXX: Lô wafer Y: Mã năm

WW: Mã tuần, 01-52

ZZ: số sê-ri, 01-99 hoặc A0-ZZ F, S: mã kiểm soát nội bộ, 1-9 hoặc AZ, az



XXXXXX: Lô wafer Y: Mã năm WW: Mã tuần, 01-52

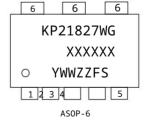
ZZ: số sê-ri, 01-99 hoặc A0-ZZ

S: mã kiểm soát nội bộ, 1-9 hoặc AZ, az



Tiêu chuẩn 8

XXXXXX: lô wafer Y: Mã năm WW: Mã tuần, 01-52 ZZ: số sê-ri, 01-99 hoặc A0-ZZ F, S: mã kiểm soát nội bộ, 1-9 hoặc AZ, az





Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Đồng hồ đo công suất tiêu biểu (1)

		230VAC ± 15%(2)	85 - 265VAC	
sản phẩm	Đóng gói	Bộ chuyển đổi(3)	Bộ chuyển đổi(3)	
KP21822M	Tiêu chuẩn 8	15W	12W	
KP21823	Tiêu chuẩn 7	18W	15W	
KP21824	Tiêu chuẩn 7	21 tuần	18W	
KP21824L	Tiêu chuẩn 8	21 tuần	18W	
KP21824M	Tiêu chuẩn 8	21 tuần	18W	
KP21825C	Tiêu chuẩn 8	24W	21 tuần	
KP21824L	ASOP-6	24W	21 tuần	
KP21827M	DIP-8	27W	24W	
KP21827	ASOP-6	27W	24W	

⁽¹⁾ Công suất đầu ra tối đa bị giới hạn bởi nhiệt độ mối nối chip.

Mô tả chức năng Pin

Ghim ASOP-6	Ghim SOP-8/DIP-8	Ghim Tiêu chuẩn 7	Tên I/0(4)	mô tả
1	2	7	GND	Chân nố:	i đất tham chiếu G Chip
2	1	1	VDD	Chân d	ấp nguồn chip P
3	-	3	NC	- Lơ :	lửng
4	3	2	FB	I Đầu	ra phản hồi và phát hiện khử từ
5	4	4	Khoa học	I Chân	đầu vào lấy mẫu hiện tại
6	5, 6, 7, 8	5,6	Làm khô hạn	P ống thơ	át nước của ống điện bên trong

(4) I - đầu vào; P - nguồn điện; G - đất

^{(2) 230}VAC hoặc 100/115VAC với bộ tăng điện áp.

⁽³⁾ Điều kiện thử nghiệm công suất điển hình: nhiệt độ môi trướng Ta = 50°C, IC Drain có đủ tấm đồng để tân nhiệt và bộ chuyển đổi được bịt kín hoàn toàn và kín khí



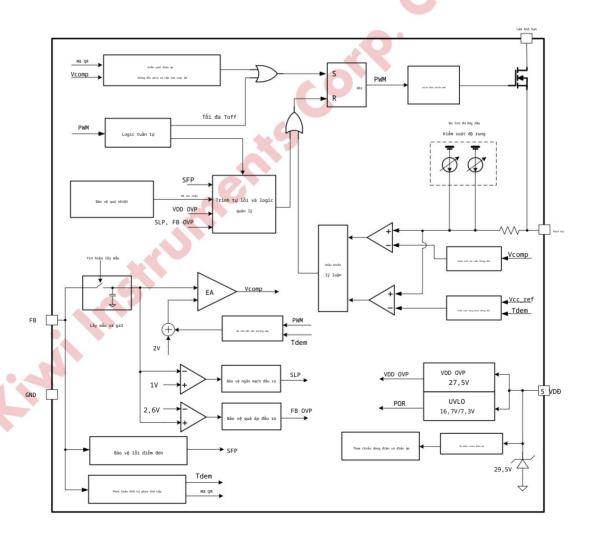
Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Thông tin đặt hàng

Đặt hàng Model(5)	mô tả
KP21822MSGA	SOP-8, không chứa halogen, băng và cuộn, 4000 chiếc/cuộn
KP21823SGA	SOP-7, không chứa halogen, băng và cuộn, 4000 chiếc/cuộn
KP21824SGA	SOP-7, không chứa halogen, băng và cuộn, 4000 chiếc/cuộn
KP21824LSGA	SOP-8, không chứa halogen, băng và cuộn, 4000 chiếc/cuộn
KP21824MSGA	SOP-8, không chứa halogen, băng và cuộn, 4000 chiếc/cuộn
KP21825CSGA	SOP-8, không chứa halogen, băng và cuộn, 4000 chiếc/c <mark>uộn</mark>
KP21827MDP	DIP-8, không chì, 50 chiếc/ống
KP21824LWGA	ASOP-6, không chứa halogen, băng và cuộn, 5000 chiếc/cuộn
KP21827WGA	ASOP-6, không chứa halogen, băng và cuộn, 5000 chiếc/cuộn

(5) Nếu chữ số cuối cùng của số đơn hàng là "A", sản phẩm sẽ được vận chuyển trong bao bì dán băng keo

Sơ đồ khối chức năng bên trong





Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Tham số giới hạn (6)

tham số		Số	đơn vị
Điện áp cung cấp DC VDD	-0,3 ~ 33	V	
Dòng kẹp DC VDD		5	mA
Điện áp xả		-0,3 ~ 650	V
Phạm vi điện áp FB		-0,7 ~ 5,5	V
Phạm vi điện áp CS		-0,3 ~ 5,5	V
		165	°C/W
Khả năng chịu nhiệt của gói tiếp giáp với môi trướng xung quanh (509-7/8)		105	°C/W
Khá nàng chịu nhiệt của gói ··· tiếp giáp với môi trư ông xung quanh (OIP-E)		120	°C/W
Khá năng chiu mhiệt của gói tiếp giáp với môi trướng xung quanh (ASOP-6)		165	°C
Nhiệt độ mối nổi hoạt động chip tối đa		-40 ~ 165	°C
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ		260	°C
Nhiệt độ hàn (hàn, 10 giây)			
Mô hình cơ thể người ESD		3	kV
Mô hình thành phần sạc ESD		2	kV
	KP21822M	2	MỘT
	KP21823	3	MỘT
	KP21824	2	MỘT
	KP21824M	4	MỘT
Dòng điện thoát tối đa ID (DC)	KP21824L (SOP-8)	4	MỘT
	KP21825C	2.7	MỘT
	KP21827M	7	MỘT
	KP21824L (ASOP-6)	4	MỘT
	KP21827	3,5	MỘT
	KP21822M	8	MỘT
	KP21823	12	MỘT
	KP21824	8	MỘT
	KP21824M	16	MỘT
Dòng điện thoát tối đa IDM (xung)	KP21824L (SOP-8)	16	мŷт
	KP21825C	8.1	МÔТ
	KP21827M	28	MỘT
	KP21824L (ASOP-6)	16	MỘT
	KP21827	10,5	MỘT



Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Điều kiện hoạt động đư ợc khuyến nghị

tham số	Số	đơn vị
Điện áp VDD	9 ~ 25	V
Nhiệt độ mối hoạt động của chúp	-40 ~ 125	°C

Thông số điện (TA= 25°C, VDD=10V, trừ khi có quy định khác)

Than xố tư ơng trư ng wàs san và quyền Whin cung cấp điển (chân vào) IVOD_ST Đông điển (chân vào) IVOD_ST Đông điển khởi động VDD VDO-VDD_ON IVOD_OR Đồng điển hoạt động tinh(7) VDO_ON Điện ấp bật VDD VDD_OPF Điện ấp tất VDD VDD_OPF Điện ấp kệt VDD VDD_OPP Ngư Đơng VDD OVP VDD_Clamp Điện ấp kẹp VDD Tổi(VDD) > 8 mA 27,5 29,5 31,5 V Ngường bắo về ngắn mạch VFE_SIP (7) TRE_Thời gian phán hỗi bảo về quả áp TFE_OVP Ngư Đơng so sánh khủ từ (FB > 1,4V) Ngư Đơng so sánh khủ từ (FB > 1,4V) Ngư Đơng so sánh khủ từ (FB > 1,4V) Tổi gian che chấn khủ từ Tellank Tổi gian the chấn khủ từ Tellank Tổi gian the chấn khủ từ Tellank Tổi gian the chấn khủ từ Tellank Tổi mọc (7) 1.8 2 2.2 μs Tổi mọc (7) 1.8 2 2.2 μs Tổi Trif mox Thời gian the chấn thủ từ Tellank Tổi Trif mox Thời gian thọt thời đại (7) Fmax Tần số họat động tối đạ (7)	0			D.			
TVDD_st Dòng diện khải động VDD VDD-VDD_on 0	Tham số tượn	g trưng	Điều kiện thử nghiệm	Đơn vị	Tối thiểu	-Tối đa	
IVDD_OP VDD dong diện hoạt dộng tĩnh(7) 200 330 500 μA	Phần cung cấp điện	(chân VDD)					
VDD_ON Diện ấp bất VDD	IVDD_st Dòng	điện khởi động VDD	VDD <vdd_on< td=""><td>0</td><td>0,5</td><td>15</td><td>μΑ</td></vdd_on<>	0	0,5	15	μΑ
VDD_OFF Diện ấp tất VDD	IVDD_Op VDD	dòng điện hoạt động tĩnh(7)		200	330	500	μΑ
VDD_OVP Ngư Ping VDD OVP 25 27.5 30 V	VDD_ON Điện	áp bật VDD		15,5	16,7	17,5	٧
VDD_Clamp Diện áp kẹp VDD Tổi (VDD) > 8 mA 27,5 29,5 31,5 V 80 phận điều khiến phán hỗi (Chân FB) VFBREFF Đầu vào tham chiếu bộ khuếch đại lỗi nội bộ 1,97 2.0 2.02 V Ngư đng bảo về ngắn mạch VFB_SLP (7) 1 V 1 V Ngư đng bảo về quả áp VFB_OVP (7) 2.6 V Thời gian phán hỗi bảo về quả áp TFB_OVP 3 Xe đạp Ngư đng so sánh khứ từ (FB < 1,4V)	VDD_OFF Điện	áp tắt VDD		6	7.3	8	٧
80 phản điều khiến phản hỗi Li (Chân FB) VFBREF Đầu vào tham chiếu bộ khuếch đại lỗi nội bộ 1,97 2.0 2.02 V Ngư ông bảo vệ ngắn mạch VFB_SLP (7) 1 V TFB_Thời gian phần hỗi bảo vệ ngắn mạch (7) 50 Ngư ông bảo vệ quá áp VFB_OVP (7) 2.6 V Thời gian phần hỗi bảo vệ quá áp TFB_OVP 3 Xe đạp Ngư ông trên 20 mV Ngư ông trên -20 mV Ngư ông trên 50 mV Ngư ông trên 50 mV Ngư ông trên 50 mV Tôn_max Thời gian mở tối đa (7) 1.8 2 2.2 μs Tái nhẹ (7) 1.8 2 2.2 μs Tái nhẹ (7) 1.8 2 2.2 μs Tái nhẹ (7) 3.1 3,5 3.9 μs Tái nhẹ (7) 3.4 3.9 4,5	VDD_OVP Ngư	ซีng VDD OVP		25	27,5	30	٧
VFBREF Đầu vào tham chiếu bộ khuếch đại lỗi nội bộ 1,97 2.0 2.02 V Ngư ỡng bảo về ngắn mạch VFB_SLP (7) 1 V TFB_Thời gian phản hỗi bảo về ngắn mạch (7) 50	VDD_Clamp Điế	n áp kẹp VDD	Tôi(VDD) > 8 mA	27,5	29,5	31,5	٧
Ngư ởng bào vệ ngắn mạch VFB_SLP (7) 1 V TFB_Thời gian nhân hồi bào vệ ngắn mạch (7) 50	Bộ phận điều khiển ph	ản hồi (Chân FB)		90		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TFB_Thời gian phần hồi bảo vệ ngắn mạch (7) 50	VFBREF Đầu vào	tham chiếu bộ khuếch đại lỗi nội bộ	60	1,97	2.0	2.02	٧
Ngư ỡng bảo vệ quá áp VFB_OVP (7) 2.6 V Thời gian phần hồi bảo vệ quá áp TFB_OVP 3 Xe đạp Ngư ỡng so sánh khử từ (FB < 1,4V)	Ngư ỡng bảo vệ	ngắn mạch VFB_SLP (7)	6		1		V
Ngư ởng so sánh khử từ (FB < 1,4V) Ngư ởng trên 20 mV	TFB_Thời gian բ	hản hồi bảo vệ ngắn mạch (7)			50		hijoh da në ving
Ngư ỡng so sánh khử từ (FB < 1,4V) Ngư ỡng trên 20 mV	Ngư ỡng bảo v	ệ quá áp VFB_OVP (7)			2.6		V
VFB_DEM Ngư ỡng so sánh khử từ (FB < 1,4V) Ngư ỡng thấp hơn -20 mV Ngư ỡng so sánh khử từ (FB>1,4V) Ngư ỡng thấp hơn 50 mV Ton_max Thời gian mở tối đa (7) 32 μs Thời gian che chấn khử từ Tblank Tái nhọ (7) 1.8 2 2.2 μs Toff_max Thời gian tất tối đa (7) 3.1 3,5 3.9 μs	Thời gian phản	hồi bảo vệ quá áp TFB_OVP			3		Xe đạp
VFB_DEM Ngư ỡng thấp hơn -20 mV Ngư ỡng so sánh khử từ (FB>1,4V) Ngư ỡng trấp 50 mV Ton_max Thời gian mở tối đa (7) 32 μs Thời gian che chắn khử từ Tblank Tải nậng (7) 1.8 2 2.2 μs Toff_max Thời gian tất tối đa (7) 3.4 3.9 4,5			Ngư ỡng trên		20		mV
Ngư ỡng so sánh khử từ (FB>1,4V) Ngư ỡng trên 50 mV Ton_max Thời gian mở tối đa (7) 32 μs Thời gian che chấn khử từ Tblank Tái nhẹ (7) 1.8 2 2.2 μs Toff_max Thời gian tất tối đa (7) 3.1 3,5 3.9 μs	VED DEM	Ngư ỡng so sánh khứ từ (FB < 1,4V)	Ngư ỡng thấp hơn		-20		mV
Ngư ỡng thấp hơn -170 mV Ton_max Thời gian mở tối đa (7) 32 μs Thời gian che chấn khử từ Tblank Tải nhẹ (7) 1.8 2 2.2 μs Toff_max Thời gian tất tối đa (7) 3.1 3,5 3.9 μs	VI B_DEN	103	Ngư ỡng trên		50		mV
Thời gian che chấn khử từ Tblank		Ngư ỡng so sánh khứ từ (FB>1,4V)	Ngư ỡng thấp hơn		-170		mV
Thời gian che chấn khử từ Tblank Tải nặng (7) 3.1 3.5 3.9 µs Toff_max Thời gian tất tối đa (7) 3.4 3.9 4.5	Ton_max Thời	gian mở tối đa (7)			32		μs
Tái nặng (7) 3.1 3,5 3.9 μs Toff_max Thời gian tắt tối đa (7) 3.4 3.9 4,5		5 112 18 712 1	Tải nhẹ (7)	1.8	2	2.2	μs
Ton 2 max mod grant care cor as (1)	Thời gian che	cnan khư từ Ibiank	Tải nặng (7)	3.1	3,5	3.9	μs
Fmax Tần số hoạt động tối đa (7)	Toff_max Thời	gian tắt tối đa (7)		3.4	3.9	4,5	bijele da sel seleg
	Fmax Tần số	hoạt động tối đa (7)		90	100	110	kHz
Bù trừ tổn thất đư ờng dây tối đa của CDC, Vcdc / Vout(7)	Bù trừ tổn thấ	đường dây tối đa của CDC, Vcdc / Vout(7)			3		%



Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bào vệ lỗi điểm đơn

						-	
Phần lấy mẫu hiện tại (chân CS)							
Thời gian cắt	cạnh trước của TLEB			400		ns	
Ngư ỡng bảo vệ	quá dòng Vcs_max tối đa (7)		755	785	815 mV		
Ngư ỡng bảo vệ	quá dòng Vcs_min tối thiểu (7)		170	180	190mV		
Độ trễ tắt	bảo vệ quá dòng TD_OC			100		ns	
Vòng lặp CC	Vòng lặp CC						
Giá trị tham ch	iếu vòng lặp CC VCC_ref		0,33	0,34	0,35	V	
Bảo vệ quá nhiệt							
TSD	Tắt nhiệt(7)		150	155	160°C		
TRC	Phục hồi quá nhiệt (7)		120	125	130°C		
Phần MOSFET n	guồn (Chân thoát)						
Điện áp đánh t	hủng cực máng-nguồn MOSFET công suất VBR(8)		650			V	
		KP21822M		5.3	6.4	Ω	
		KP21823		2.9	3,5	Ω	
		KP21824		2.2	2,5	Ω	
		KP21824M		2.2	2.6	Ω	
Rdson tĩnh t	hoát-nguồn trên-điện trở	KP21824L (SOP-8)		2.6	3.1	Ω	
	KP21825C		1.6	1.8	Ω		
	hoát-nguồn trên-điện trở	KP21827M		1.2	1.4	Ω	
		KP21824L (ASOP-6)		2.6	3.1	Ω	
	6	KP21827		1,25	1,45	Ω	

⁽⁶⁾ Vư ợt quá các thông số giới hạn trong bằng có thể gây hư hồng vĩnh viễn cho chip. Các thông số giới hạn là giá trị ứng suất định mức. Trong điều kiện vận hành và áp lực vư ợt quá mức khuyến nghị

Thiết bị có thể không hoạt động bình thư ông và không nên vận hành thiết bị trong những điều kiện này. Tiếp xúc quá mức với các điều kiện vư ợt quả điều kiện vận hành tối đa đư ợc khuyến nghị có thể ảnh hư ông đến thiết bị

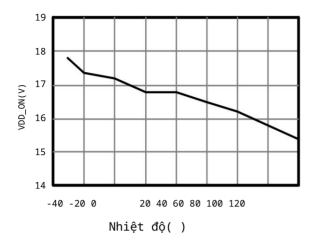
độ tin cậy.

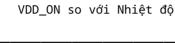
⁽⁷⁾ Các thống số phụ thuộc vào thiết kế và phải vư ợt qua các thử nghiệm chức năng trong quá trình sản xuất hàng loạt.

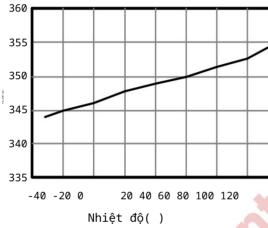
⁽⁸⁾ Đối với KP21824L (SOP-8/ASOP-6), điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn tối thiểu của MOSFET là 620V và thời gian chịu đựng cho phép nhỏ hơn 200ns và biên độ không vư ợt quá Điện áp đỉnh trên 650V.

Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

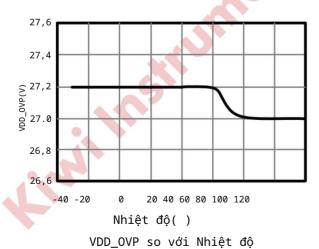
Đường cong đặc tính tham số





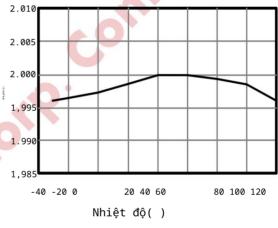


VCC_REF so với Nhiệt độ



9 8 7 6 5 4 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Nhiệt độ()

VDD_OFF so với Nhiệt độ



VFB_REF so với Nhiệt độ

Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Mô tả chức năng

KP2182X là công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp cộng hư ởng bán hiệu suất cao Công tắc, đặc biệt thích hợp cho ứng dụng sạc. Trong điều kiện đầu ra tải đầy đủ, KP2182X hoạt động theo cơ chế cộng hư ởng gần đúng trên toàn bộ đải điện áp đầu vào chế độ, do đó đạt được hiệu suất và khá năng tăng nhiệt độ tuyệt với.

Khởi động hệ thống

Trư ớc khi chíp bất đầu hoạt động, KP2182X chỉ tiêu thụ

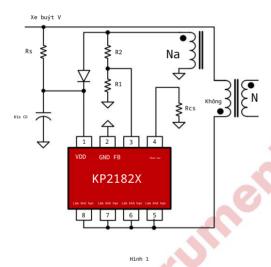
Dòng điện khởi động IVDD_st (thư ờng là 0,5µA), dòng điện khởi động cực thấp

Có thể giúp tăng giá trị điện trở khởi động để giảm mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ

Mục đích. Khi điện áp VDD vư ợt quá điện áp bật VDD_ON (giá trị điển hình

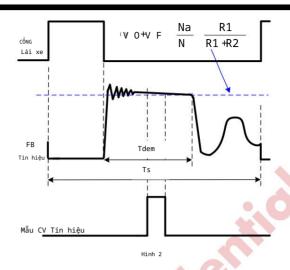
16,7V), IC bất đầu hoạt động và sau khi điện áp đầu ra đư ợc thiết lập, cuộn đây phụ

Cung cấp năng lư ơng cho chip.



Điều khiển điện áp không đổi phía chính (Chế độ PSR-CV)

Khi phía sơ cấp của máy biến ấp truyền năng lử dng sang phía thứ cấp,
Điện áp cuộn dây phụ dư ợc ghép nối với cuộn dây có thể đư ợc sử dụng để có đư ợc phân hồi diện áp dầu ra
Tín hiệu. Hình 2 cho thấy quá trình lấy mẫu diện áp bên trong và khử từ của KP2182X
Các dạng sóng chính để phát hiện và kích hoạt thung lũng cộng hư ởng. Khi quá trình lấy mẫu áp suất không đổi
Cuối cũng, mô-đun lấy mẫu và giữ bên trong ghi lại lỗi phân hồi và chuyển nó đến
Nó đư ợc khuếch đại bởi bộ khuếch đại lõi bên trong. Kiểm soát điện áp không đổi phía sơ cấp
Mô-đun sử dụng đầu ra của bộ khuếch đại hoạt động lỗi để đạt đư ợc điện áp không đổi có độ chính xác cao
Dầu ra. Tham chiếu đầu ra điện áp không đổi bên trong của chip là VFBREF (giá trị điển hình

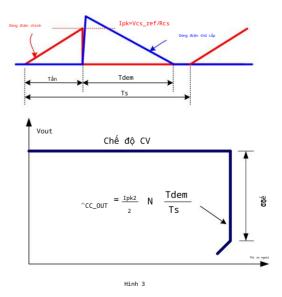


Hình 2 cũng cho thấy mối quan hệ định lượng của nền tảng điện áp FB trong quá trình khử từ:

$$V_BV$$
 ($_{b}$ $R1 = + NS R1 R2$

Trong đó: Vo và VF lần lư gt là điện áp đầu ra và diode tự do phía thứ cấp.
Điện áp trạng thái bật; R1 và R2 đư gc kết nối với chân F8 bằng cuộn dây phụ
Các điện trở phân áp; Ns và Na lần lư gt là cuộn dây thứ cấp và cuộn dây phụ
Số vòng quây.

Điều khiển dòng điện không đổi phía chính (Chế độ PSR-CC)



Như thế hiện trong Hinh 3, dòng điện cảm ứng chính, tỷ lệ vòng dây của máy biến áp và tiêu tán phía thứ cấp Thời gian từ tính (Tdem) và thời gian chu kỳ chuyển mạch (Tsw) xác định phía thứ cấp Dòng điện đầu ra trung binh. Nếu bỏ qua tác động của độ tự cảm rò rì, đầu ra trung binh của phía thứ cấp là



Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Công thức tính dòng điện đầu ra đư ợc thể hiện ở Hình 3.

Ở chế độ CC, KP2182X cũng hoạt động ở trạng thái cộng hư ởng gần. Bằng cách tự động điều chính giá trị tham chiếu của Vcs, dòng điện đầu ra không đổi được đảm bảo. Mối quan hệ giữa động điện đầu ra trung binh thực tế và Rcs có thể được biểu thị như sau:

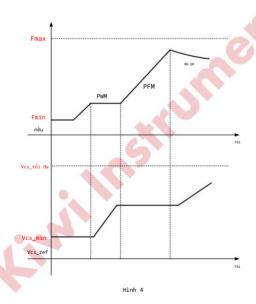
**CC_OUT
$$\frac{\text{cc}_{\text{ref}}}{2}$$
 $\frac{\text{ref}}{\text{R}_{\text{cs}}}$

Trong đó: N là tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp; Rcs
là điện trở lấy mẫu đư ợc kết nối giữa cực S của MOSFET công suất và GND; Vcc_ref là giá trị
tham chiếu của vòng CC.

Hoạt động điện áp không đổi đa chế độ

Như thế hiện trong Hình 4, để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu suất trung bình và công suất dự phòng, KP2182X áp dụng công nghệ điều khiến đa chế độ kết hợp điều khiến điều chế biên độ (AM) và điều khiến điều chế tần số (FM).

Trong điều kiện tải nặng, KP2182X hoạt động ở trạng thái cộng hư ởng gần đúng để đảm bảo Chứng minh hiệu suất tuyệt vởi và khả nâng tăng nhiệt độ. Khi tải giảm, IC sẽ chuyển sang chế độ điều chế tần số (FM) rồi đến chế độ điều chế biên độ (AM) để đạt đư ợc mục đích cải thiện hiệu suất tải nhẹ và giảm nhiễu.



Bù trừ tổn thất đường dây tích hợp (CDC)

Trong ứng dụng bộ sạc điện thoại di động, pin và bộ sạc thư ởng được kết nối bằng một đoạn cáp có độ dài nhất định, điều này cũng sẽ khiến nguồn điện truyền đến pin

Điện áp ở đầu pin tạo ra một mức sụt áp nhất định. Cáp tích hợp KP2182X

Chức năng bù tổn thất đường dây điều chính lượng bù tổn thất đường dây theo sự thay đổi tái.

Điều này cho phép đầu ra của cáp có được đường cong điện áp đầu ra không đổi và phẳng. Giá

trị bù tổn thất đường dây tối đa là 3% điện áp đầu ra.

Bù dòng điện áp không đổi

MOSFET có độ trễ tắt đáng kể, điều này sẽ ảnh hư ởng đến hiệu suất đầu ra đòng điện không đối của IC. Nếu không thực hiện bù, giá trị OCP ở đầu vào điện áp cao sẽ cao hơn nhiều so với giá trị ở đầu vào điện áp thấp. KP2182X có mạch bù dòng điện áp không đối tích hợp, có thể điều chính dòng điện đầu ra tuyệt với.

Phản hồi động được tối ư u hó

KP2182X đư ợc tối ư u hóa để có hiệu suất phản hồi động nhằm đáp ứng các yêu cầu của bộ są USB.

Hoạt động mà không có âm thanh bắt thư ởng

Như đã để cập ở trên, KP2182X áp dụng công nghệ điều khiến đa chế độ kết hợp điều khiến điều chế tần số và điều khiến điều chế biên độ ở chế độ đầu ra điện áp không đối, có thể hoạt động không gây tiếng ổn từ chế độ đầy tài đến không tải.

Bảo vệ lỗi điểm đơn của hệ thống cung cấp điện

KP2182X tích hợp bảo vệ lỗi điểm đơn, bao gồm bảo vệ mạch hở điện trở kéo lên FB, bảo vệ mạch hở điện trở kéo xuống FB, bảo vệ ngắn mạch điện trở kéo xuống FB,
Bảo vệ mạch, điode đầu ra hoặc ngắn mạch SR, mạch hở RCS, máy biến áp
Ngoài ra còn có chức năng bảo vệ chống lại hiện tượng đoàn mạch cuộn đây biến áp, hở chân IC GNO, v.v. Một khi
Nếu xây ra lỗi, chip sẽ chuyển sang chế độ bảo vệ và tự động khởi động lại. Chức năng bảo vệ
lỗi một điểm của IC có thể đẩm bảo IC không bị hóng và đầu ra không tạo ra quá điện áp.

Bảo vệ ngắn mạch (FB SLP)

Bên trong KP2182X, điện áp đầu ra được lấy mẫu theo thời gian thực thông qua chân FB và so Sánh với ngư ởng bào vệ điện áp thấp VFB_SLP (giá trị điển hình là 1V).

Khi điện áp FB lấy mẫu thấp hơn VFB_SLP và kéo dài hơn TFB_Short (giá trị điển hình là 50ms), chip sẽ vào chế độ bảo vệ ngắn mạch và tự động khởi động lại.



Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Bảo vệ quá áp (FB OVP)

Bên trong KP2182X, điện áp đầu ra được lấy mẫu theo thời gian thực thông qua chân FB và so sánh với ngư ỡng bảo vệ quá áp VFB_OVP (giá trị điển hình là 2,6V).

Khi điện áp FB lấy mẫu cao hơn VFB_OVP và kéo dài trong TFB_OVP (giá trị điển hình là 3 chu kỳ), chip sẽ vào chế độ bảo vệ quá áp và tự động khởi động lại.

Bảo vệ quá áp VDD (OVP) và kẹp

Khi điện áp VDD vư ợt quá VDD_OVP (giá trị thông thư ờng là 27,5V), chip sẽ ngay lập tức dừng chuyển mạch. Điều này sẽ khiến VDD giảm xuống và khi điện áp VDD thấp hơn điện áp tắt VDD_OFF (giá trị thông thư ờng là 7,3V), hệ thống sẽ khởi động lại.

Một mạch kẹp đư ợc thiết kế bên trong chip để ngăn chip bị hỏng. Điện áp kẹp là VDD_Clamp (giá trị điển hình là 29,5V).

Bảo vệ quá nhiệt (OTP)

Khi nhiệt độ mối nối chip vư ợt quá TSD (giá trị điển hình là 155°C), chip sẽ dừng chuyển mạch và VDD sẽ tất nguồn rồi khởi động lại; chip chỉ có thể tiếp tục chuyển mạch khi nhiệt độ mối nối chip thấp hơn TRC (giá trị điển hình là 125°C).

Trình điều khiển mềm

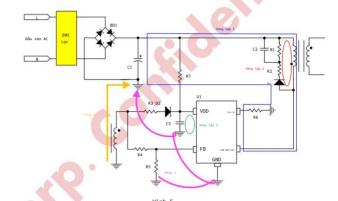
Chức năng ổ đĩa mềm của KP2182X tối ư u hóa hệ thống
Hiệu suất EMI của hệ thống. IC đư ợc thiết kế với mạch kẹp Gate mức cao 16V để ngặn
ngữa hư hộng Gate khi xảy ra đầu vào VDD cao.

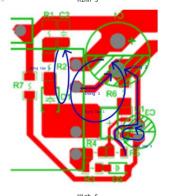
Hư ớng dẫn ứng dụng

Gợi ý thiết kế PCB

Thiết kế PCB có tác động đáng kể đến EMI, ESD và hiệu suất khác của nguồn điện. Nên tham khảo Hình 5 và 6 khi thiết kế mạch chính.

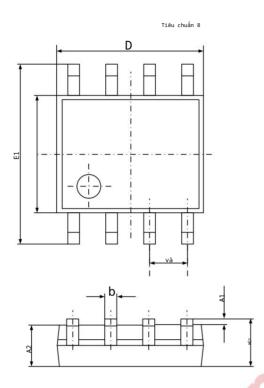
- Diện tích của mạch vòng nguồn chính (Loop1) phải càng nhỏ càng tốt.
 Đồng thời, các vết phải càng dây càng tốt để tối ư u hóa hiệu quả.
- 2. Diện tích vòng hấp thụ RCD (Vòng 2) phải càng nhỏ càng tốt.
- 3. Tụ điện VDD C3 phải gần với chip để đảm bảo vòng lặp VDD
 - Diện tích của (Loop3) càng nhỏ càng tốt.
- 4. Như thể hiện ở Dòng 1, cuộn dây phụ phải được kết nối trực tiếp với tụ điện đầu vào. nối đất để giảm nhiễu năng lượng ESD trên chip.
- 5. Như thể hiện ở Dòng 2, tụ điện VDD C3 và điện trở FB RS
 Nên kết nối với chân GND của chip trư ớc, sau đó đến đầu vào
 Tu điện nối đất.

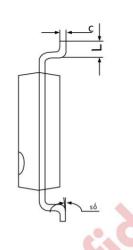






Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

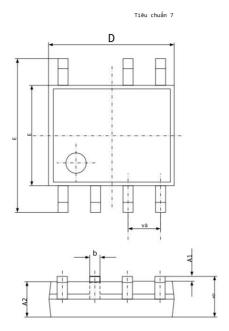


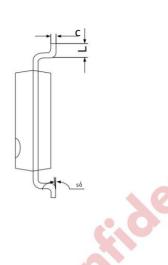


	Kích thu	đớc (mm)	Kích thư ớc (inch)	
biểu tượng	Tối thiểu	tối đa	Tối thiểu	tối đa
мŷт	1.350	1,750	0,053	0,069
A1	0,100	0,250	0,004	0,010
A2	1.300	1.500	0,051	0,059
b	0,330	0,510	0,013	0,020
С	0,170	0,250	0,007	0,010
D	4.700	5.100	0,185	0,201
E	3.800	4.000	0,150	0,157
E1	5.800	6.200	0,228	0,244
và	1.270 (từ tâm đến tâm)		0,050 (từ tâm đến tâm)	
	0,400	1.270	0,016	0,050
số	0°	8°	0°	8°



Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn



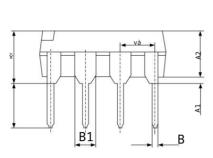


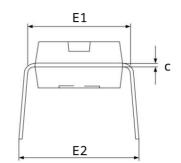
	Kích thu	ſớc (mm)	Kích thư ớc (inch)	
biểu tượng	Tối thiểu	tối đa	Tối thiểu	tối đa
мộт	1.350	1,750	0,053	0,069
A1	0,100	0,250	0,004	0,010
A2	1.300	1.500	0,051	0,059
b	0,330	0,510	0,013	0,020
С	0,170	0,250	0,007	0,010
D	4.700	5.100	0,185	0,201
E	3.800	4.000	0,150	0,157
E1	5.800	6.200	0,228	0,244
và	1.270	(BSC)	0,050 (BSC)	
. 1	0,400	1.270	0,016	0,050
số	0°	8°	0°	8°

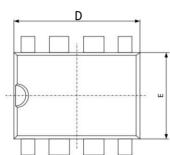


Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

DIP-8



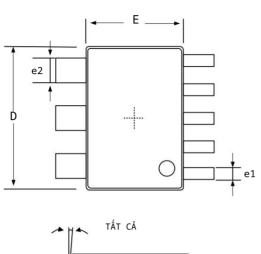


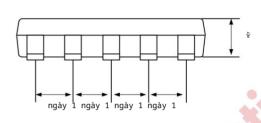


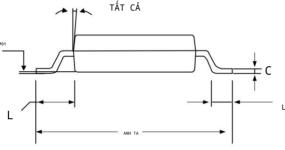
	\$ B1	B P	E2	rid
			Cour	96 LL
bíểu tượng	Kích thu	ſớc (mm)	Kích thư ớc (inch)	
bieu tượng	Tối thiểu	tối đa	Tối thiều	tối đa
мộт	3.600	4.150	0,142	0,163
A1	0,510	*5	0,020	-
A2	3.150	3.400	0,124	0,134
В	0,380	0,560	0,015	0,022
B1	1.524 (từ t	âm đến tâm)	0,060 (tâm tới tâm)	
С	0,200	0,350	0,008	0,014
D	9.000	9.400	0,354	0,370
E	6.200	6.500	0,244	0,256
E1	7.620 (Tham khảo)		0,300 (Tham chiếu)	
và	2.540 (từ tâm đến tâm)		0,100 (tâm	tới tâm)
L	3.000	3.600	0,118	0,142
E2	7.620	9.300	0,300	0,366

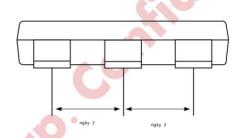
Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

ASOP-6





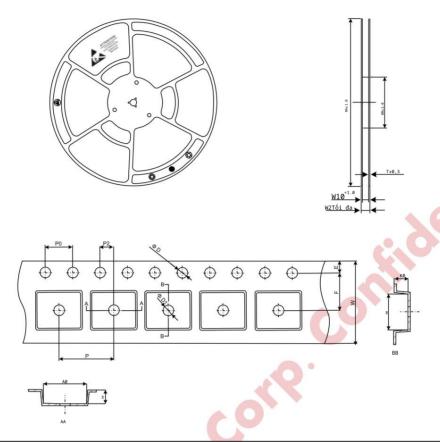




		Kích thư ớc (mm)			Kích thư ớc (inch)	
biểu tư ợng	Tối thiểu	đặc trư ng	tối đa	Tối thiểu	đặc trưng	tối đa
MỘT	1.050	1.150	1.250	0,041	0,045	0,049
Một		0,200 (Tham chiếu)			0,008 (Tham chiếu)	
С	0,150	0,200	0,220	0,006	0,008	0,009
D	6.000	6.200	6.400	0,236	0,244	0,252
ngày 1	1.250	1.300	1.350	0,049	0,051	0,053
ngày 2	1,950	2.000	2.050	0,077	0,079	0,081
Е	3.700	3.900	4.100	0,146	0,154	0,161
e1	0,350	0,400	0,450	0,014	0,016	0,018
e2	1.550	1.600	1.650	0,061	0,063	0,065
ANH TA	5.900	6.000	6.100	0,232	0,236	0,240
Ľ	0,950	1.050	1.150	0,037	0,041	0,045
L1	0,400	-	0,800	0,016	-	0,031
		12°				

Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Thông tin về băng và cuộn băng



Kích thước cuộn (mm)					
мộт	8 (Đư ởng kính bên trong)	W1	W2 Tối Đa	T	
330	100	12.4	18.4	1,5	

Kích thư ớc băng				
bíểu tư ợng	Kích thước (mm)	bíểu tượng	Kích thước (mm)	
E	1,75±0,10	Т	12,00±0,10	
F	5,50±0,10	Р	8,00±0,10	
P2	2,00±0,10	A0	6,60±0,10	
D	1,50 0 +0,1	В0	5,30±0,10	
Ngày 1	1,55±0,05	К0	1,90±0,10	
P0	4,00±0,10			

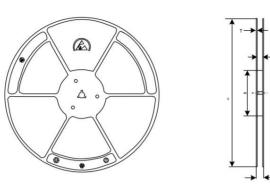
Số lượng đóng gói				
Bư u kiện	Mảnh/Gói	Khay /Hộp	Höp/Tháng các tông	Mảnh/hộp
Tiêu chuẩn 7	4000	2	8	64000
Tiêu chuẩn 8	4000	2	8	64000

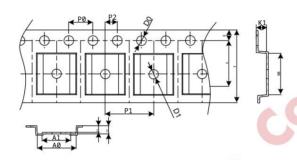


Gideniio)

Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

Thông tin về băng và cuộn băng





Kích thư ớc cuộn (mm)				
мộт	B (Đường kính bản trong)	E	F	Т
330±2	100±1	16,9±0,5	12,7 ⁺²	2,1±0,2

Kích thư ớc bằng				
bíểu tượng	Kích thước (mm)	biểu tư ợng	Kích thước (mm)	
AØ	6,40±0,10	K1	1,50±0,10	
В0	6,60±0,10	Е	1,75±0,10	
KØ	1,70±0,10	F	5,50±0,05	
PØ	4,00±0,10	Ngày 0	1,55±0,05	
P1	8,00±0,10	Ngày 1	1,55±0,05	
P2	2,00±0,05	Т	12,0±0,30	
A1	3,80±0,10			

Số lượng đóng gói				
Bư u kiện	Mảnh/Gói	Khay/Hộp	Ибр/Thing các tổng	Mảnh/hộp
ASOP-6	5000	2	5	50000



Công tắc nguồn điều khiển phía sơ cấp có điện áp không đổi cộng hư ởng bán hiệu suất cao và dòng điện không đổi với bảo vệ lỗi điểm đơn

tuvên bố

www.kiwiinst.com α Kiwi Instruments Corp. Bảo mật 18

Cotte Cotte